Corso di Elettronica - Anno Accademico 2016/2017 -

Stadi di Amplificazione a Singolo Transistore

 ${\bf Laurea\ Triennale\ in\ Ingegneria\ Elettronica\ e\ Tecnologie\ dell'informazione}$

Captain Mich

12th May, 2017

Contents

1	Stadio ad emettitore comune (CE)			1
	1.1	Stadio	CE ad alta z_i	2
	1.2	Stadio CE con modelli piu' dettagliati		2
		1.2.1	Modello con la resistenza di base r_b	2
		1.2.2	Modello con la resistenza r_o ed $R_e=0$	2
		1.2.3	Modello con la resistenza r_o ed $R_e \neq 0$	3
		1.2.4	Stadio CE con carico attivo	3
2	Stadio a source comune (CS)			4
	2.1	Stadio	CS ad alta z_i	5
	2.2	Stadio	CS con modelli piu' dettagliati	5
		2.2.1	Modello con la resistenza r_o ed $R_s=0$	5
		2.2.2	Modello con la resistenza r_o ed $R_s \neq 0$	5
		2.2.3	Stadio CS con carico attivo	6
3	Stadio a base comune (CB)			7
	3.1	Model	lo con la resistenza r_o	7
4	Stadio a gate comune (CG)			8
	4.1	Model	lo con la resistenza r_o	8
5	5 Stadio a collettore comune (CC)			9
6	Stadio a drain comune (CD)			10
7	Analisi in frequenza dei circuiti elettronici			11

1 Stadio ad emettitore comune (CE)

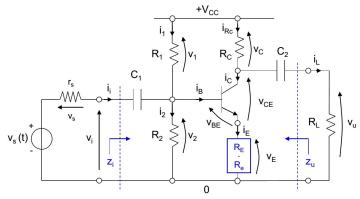
 C_2 : sono capacita' di disaccoppiamento; separano in CC ingresso e uscita dal circuito di polarizzazione.

 $r_s: z_u$ dello stadio precedente

 $R_L: z_i$ dello stadio successivo

 R_E : R su E in polarizzazione

 R_e : R su E ai p.s



 $g_m = \frac{|I_C|}{V_T}$ $r_\pi = \frac{\beta_0}{a_m}$ Formule per il calcolo ai piccoli segnali:

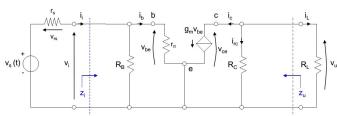


Figure 1: Circuito ai p.s con $R_e = 0$

$$\Rightarrow$$
 se $R_e = 0$

$$\Rightarrow \operatorname{se} R_{e} = 0:$$

$$A_{V} = -g_{m}(R_{C}/\!\!/R_{L}) = -\frac{R_{C}/\!\!/R_{L}}{R_{C}} \frac{V_{C}}{V_{T}} \qquad \left[|A_{V}|_{max} = \frac{V_{C}}{V_{T}} \right]$$

$$A'_{V} = \frac{z_{i}}{r_{s} + z_{i}} A_{V} = \frac{R_{B}/\!\!/r_{\pi}}{R_{C}} A_{V} \qquad z_{i} = R_{B}/\!\!/r_{\pi} \qquad z_{u} = R_{C}$$

$$V_{s}(t) \xrightarrow{r_{s}} V_{t} \xrightarrow{i_{l}} V$$

Figure 2: Circuito ai p.s con $R_e \neq 0$

$$\Rightarrow$$
 se $R_e \neq 0$

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\$$

$$z_i = R_B / [(g_m r_\pi + 1)R_e + r_\pi]$$
 $z_u = R_C$

Nota: nell'ultimo caso e' possibile effettuare alcune semplificazioni se sono verificate certe condizioni:

$$A_{V} = -\frac{g_{m}(R_{C}/\!\!/R_{L})}{g_{m}R_{e} + 1} \cong -\frac{(R_{C}/\!\!/R_{L})}{R_{e}}$$
 (se $g_{m}R_{e} >> 1$)

$$z_{i} = R_{B}/\!\!/[(g_{m}r_{\pi} + 1)R_{e} + r_{\pi}] \cong R_{B}$$
 (se $R_{B} << \beta_{0}R_{e}$)

1.1 Stadio CE ad alta z_i

Il circuito ai p.s identico a quello CE standard

$$A_{V} = -\frac{g_{m}r_{\pi}(R_{C}/\!\!/R_{L})}{(g_{m}r_{\pi} + 1)R_{e} + r_{\pi}} \cong -\frac{g_{m}(R_{C}/\!\!/R_{L})}{g_{m}R_{e} + 1}$$

$$z_{i} = R_{B}/\!\!/[(g_{m}r_{\pi} + 1)R_{e} + r_{\pi}] \qquad z_{u} = R_{C}$$

- R_B molto maggiore del CE standard \Rightarrow e' uno stadio ad alta z_i
- Nota : se l'ingresso non e' disaccoppiato in CC, R_B e' infinita

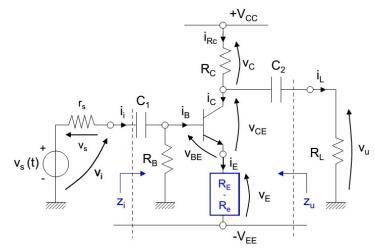


Figure 3: Circuito ad alta z_i

1.2 Stadio CE con modelli piu' dettagliati

1.2.1 Modello con la resistenza di base r_b

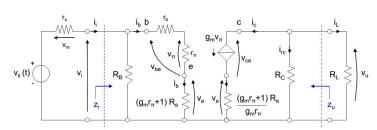


Figure 4: Circuito con r_b

$$A_V = -\frac{g_m r_\pi (R_C /\!\!/ R_L)}{(g_m r_\pi + 1) R_e + r_\pi + r_b} \cong -\frac{g_m (R_C /\!\!/ R_L)}{g_m R_e + 1 + r_b / r_\pi}$$

$$z_i = R_B /\!\!/ [(g_m r_\pi + 1) R_e + r_\pi + r_b] \qquad z_u = R_C$$

1.2.2 Modello con la resistenza r_o ed $R_e = 0$

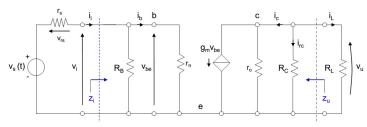


Figure 5: Circuito con r_o ed $R_e = 0$

$$A_V = -g_m(r_o/\!\!/R_C/\!\!/R_L)$$

$$z_i = R_B/\!\!/r_b \qquad z_u = r_o/\!\!/R_C$$
 v_u

1.2.3 Modello con la resistenza r_o ed $R_e \neq 0$

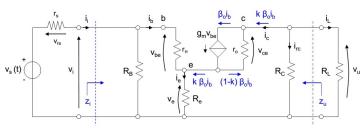


Figure 6: Circuito con r_o ed $R_e \neq 0$

$$k = \frac{\beta_o r_o - R_e}{\beta_o [R_e + (R_C /\!/ R_L) + r_o]} \cong \frac{r_o}{(R_C /\!/ R_L) + r_o}$$

$$A_V = -\frac{k g_m r_\pi (R_C /\!/ R_L)}{(k g_m r_\pi + 1) R_e + r_\pi} \cong -\frac{k g_m (R_C /\!/ R_L)}{k g_m R_e + 1}$$

$$z_i = R_B /\!/ [(k g_m r_\pi + 1) R_e + r_\pi$$

$$z_u = z_u^* /\!/ R_C \cong \{r_o (1 + g_m [r_\pi /\!/ R_e]) /\!/ R_C\}$$

1.2.4 Stadio CE con carico attivo

Versione a doppia alimentazione con:

- $R_C = r_{o,2}$ del trans. pnp dello specchio
- $r_o = r_{o,1}$ del trans. 1

$$A_V = -\frac{kg_m(r_{o,2}/\!\!/R_L)}{kg_m R_e + 1} \cong -\frac{g_m(r_{o,1}/\!\!/r_{o,2}/\!\!/R_L)}{kg_m R_e + 1}$$

Nel caso di $R_L = \infty$ ed $R_e = 0$, abbiamo:

$$\left[|A_V|_{max} = \frac{V_A + V_C}{V_T} \frac{r_{o,1}}{r_{o,1} + r_{o,2}} \right]$$

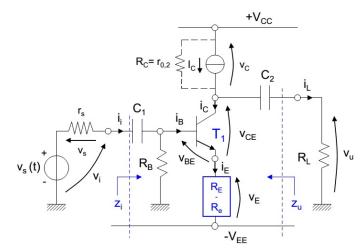


Figure 7: Stadio CE con carico attivo

$\mathbf{2}$ Stadio a source comune (CS)

sono capacita' di disaccoppiamento; sepa- C_2 : rano in CC ingresso e uscita dal circuito di polarizzazione.

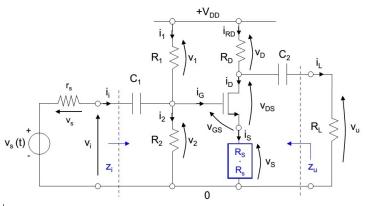
 r_s : z_u dello stadio precedente

 $R_L: z_i$ dello stadio successivo

 R_S : R su S in polarizzazione

 R_s : R su S ai p.s

Formule per il calcolo ai piccoli segnali: $g_m = \beta_n |V_{GS} - V_{Th}|$



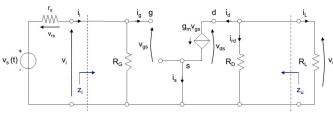


Figure 8: Circuito ai p.s con $R_s = 0$

$$A_{V} = -g_{m}(R_{D} /\!\!/ R_{L}) = -\frac{R_{D} /\!\!/ R_{L}}{R_{D}} \frac{2V_{D}}{|V_{GS} - V_{Th}|}$$

$$\left[|A_{V}|_{max} = \frac{2V_{D}}{|V_{GS} - V_{Th}|} \right] \qquad A'_{V} = \frac{z_{i}}{r_{s} + z_{i}} A_{V} = \frac{R_{G}}{r_{s} + R_{G}} A_{V}$$

$$z_{i} = R_{G} \qquad z_{u} = R_{D}$$

<u>Nota</u>: e' stato usato [$g_m = 2I_D / (V_{GS} - V_{Th})$]

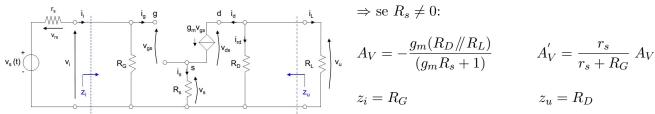


Figure 9: Circuito ai p.s con $R_s \neq 0$

$$A_V = -\frac{g_m(R_D//R_L)}{(g_m R_s + 1)}$$
 $A_V' = \frac{r_s}{r_s + R_G} A_V$

$$=R_G$$
 $z_u=R_L$

Nota: nell'ultimo caso e' possibile effettuare una semplificazione sotto opportuna condizione:

$$A_V = -\frac{g_m(R_D/\!\!/R_L)}{g_m R_s + 1} \cong -\frac{(R_D/\!\!/R_L)}{R_s}$$
 (se $g_m R_s >> 1$)

2.1 Stadio CS ad alta z_i

Il circuito ai p.s identico a quello CS standard

$$A_V = -\frac{g_m(R_D /\!\!/ R_L)}{(g_m R_s + 1)}$$

$$z_i = R_G \qquad z_u = R_D$$

- R_G molto maggiore del CS standard \Rightarrow e' uno stadio ad alta z_i
- Nota : se l'ingresso non e' disaccoppiato in CC, R_G e' infinita

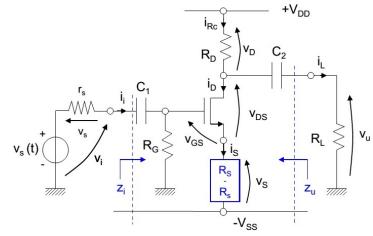


Figure 10: Circuito ad alta z_i

2.2 Stadio CS con modelli piu' dettagliati

2.2.1 Modello con la resistenza r_o ed $R_s=0$

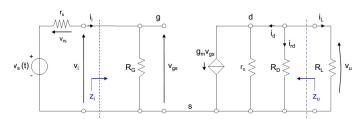


Figure 11: Circuito con r_o ed $R_s = 0$

$A_V = -g_m(r_o /\!/ R_D /\!/ R_L)$

$$z_i = R_G z_u = r_o /\!\!/ R_I$$

2.2.2 Modello con la resistenza r_o ed $R_s \neq 0$

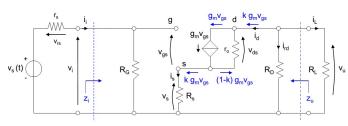


Figure 12: Circuito con
$$r_o$$
 ed $R_s \neq 0$

$$k = \frac{g_m r_o}{g_m [R_s + (R_D /\!\!/ R_L) + r_o]} \cong \frac{r_o}{(R_D /\!\!/ R_L) + r_o}$$

$$\downarrow_{i_{v_0}}$$

$$\downarrow_{i_{v_0}}$$

$$\downarrow_{i_{v_0}}$$

$$A_V = -\frac{kg_m (R_D /\!\!/ R_L)}{kg_m R_s + 1}$$

$$z_i = R_G$$

$$z_u = z_u^* /\!\!/ R_D \cong (r_o (1 + g_m R_s) /\!\!/ R_D)$$

2.2.3 Stadio CS con carico attivo

Versione a doppia alimentazione con :

- $R_D = r_{o,2}$ del trans. PMOS dello specchio
- $r_o = r_{o,1}$ del trans. 1

$$A_V = - \; \frac{kg_m(r_{o,2} /\!\!/ R_L)}{kg_m R_s + 1} \cong - \; \frac{g_m(r_{o,1} /\!\!/ r_{o,2} /\!\!/ R_L)}{kg_m R_s + 1}$$

Nel caso di $R_L = \infty$ ed $R_s = 0$, abbiamo:

$$\left[|A_V|_{max} = \frac{2(V_A + V_D)}{|V_{GS} - V_{Th}|} \, \frac{r_{o,1}}{r_{o,1} + r_{o,2}} \right]$$

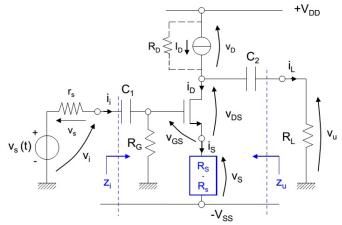


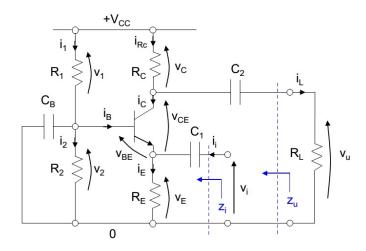
Figure 13: Stadio CS con carico attivo

3 Stadio a base comune (CB)

La porta d'ingresso e' sull'emettitore, l'uscita e' sul collettore; la base e' messa a massa da C_B nel circuito ai p.s.

 C_1 , C_2 separano in continua ingresso e uscita dal circuito di polarizzazione.

 $\underline{\mathbf{Nota}}:$ con $V_{CC}, -V_{EE}$ B e' collegata a massa e non ci sono R_B e C_B



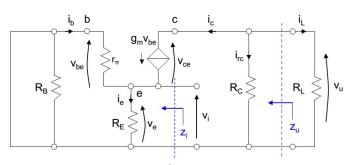


Figure 14: Circuito ai p.s

$A_V = \frac{v_u}{v_i} = gm(R_C /\!/ R_L) \qquad z_u = R_C$ $z_i = \frac{1}{g_m} /\!/ R_E /\!/ r_\pi \cong \frac{1}{g_m}$

3.1 Modello con la resistenza r_o

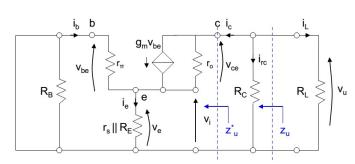


Figure 15: Circuito ai p.s

$$A_{V} = -\frac{kg_{m}r_{\pi}(R_{C}/\!\!/R_{L})}{(kg_{m}r_{\pi} + 1)R_{e} + r_{\pi}} \cong -\frac{kg_{m}(R_{C}/\!\!/R_{L})}{kg_{m}R_{e} + 1}$$

$$z_{i} = R_{B}/\!\!/[(kg_{m}r_{\pi} + 1)R_{e} + r_{\pi}$$

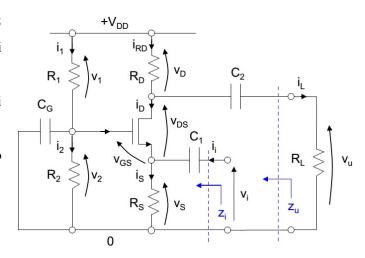
$$z_{u} = z_{u}^{*}/\!\!/R_{C} \cong \{r_{o}(1 + g_{m}[r_{\pi}/\!\!/r_{s}/\!\!/R_{E}])/\!\!/R_{C}\}$$

4 Stadio a gate comune (CG)

La porta d'ingresso e' sul source, l'uscita e' sul drain; il gate e' messo a massa da C_G nel circuito ai p.s.

 C_1 , C_2 separano in continua ingresso e uscita dal circuito di polarizzazione.

 $\underline{\mathbf{Nota}}$: con $V_{DD}, -V_{SS}$ G e' collegata a massa e non ci sono $R_G \in C_G$



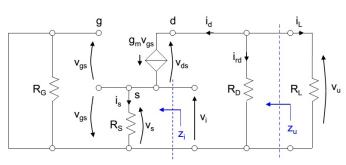


Figure 16: Circuito ai p.s

$$A_V = \frac{v_u}{v_i} = gm(R_D /\!\!/ R_L)$$

$$z_i = \frac{1}{g_m} /\!\!/ R_S \cong \frac{1}{g_m} \qquad \text{(solo se } \frac{1}{g_m} << R_S \text{)}$$

$$z_u = R_D$$

4.1 Modello con la resistenza r_o

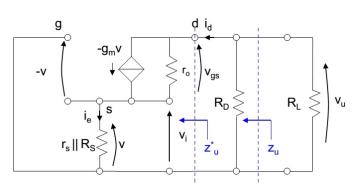


Figure 17: Circuito ai p.s

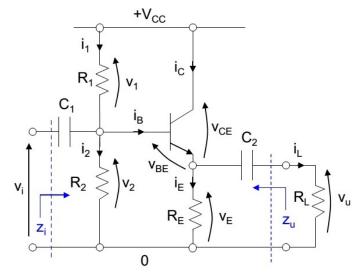
$$A_V = -\frac{kg_m(R_D/\!\!/R_L)}{kg_mR_s+1}$$

$$z_i = R_G$$

$$\mathbf{V_u} \quad z_u = z_u^* \ /\!\!/R_D \cong (r_o(1+g_mr_s)/\!\!/R_S)/\!\!/R_D$$

5 Stadio a collettore comune (CC)

La porta d'ingresso e' sulla base, l'uscita e' sullemettitore; il collettore e' collegato direttamente all'alimentazione V_{CC} Polarizzazione statica: sull'uscita si fissa di solito $V_E = V_{CE} = V_{CC}/2$, sulla porta d'ingresso si usano le stesse regole del CE.



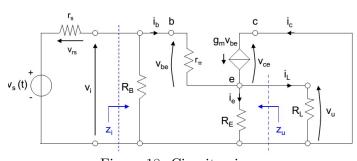


Figure 18: Circuito ai p.s

$$A_{V} = \frac{(g_{m}r_{\pi} + 1)(R_{E}/\!\!/R_{L})}{(g_{m}r_{\pi} + 1)(R_{E}/\!\!/R_{L}) + r_{\pi}} \cong \frac{g_{m}(R_{E}/\!\!/R_{L})}{g_{m}(R_{E}/\!\!/R_{L}) + 1} < 1$$

$$z_{i} = R_{B}/\!\!/[(g_{m}r_{\pi} + 1)(R_{E}/\!\!/R_{L}) + r_{\pi}]$$

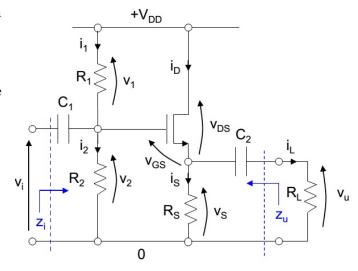
$$z_{u} = \frac{1}{kg_{m}}/\!\!/R_{E}/\!\!/(r_{s}/\!\!/R_{B}) + r_{\pi} \cong \frac{1}{kg_{m}}$$

Nota: in centro banda il carico R_L e' in parallelo con R_E

6 Stadio a drain comune (CD)

La porta d'ingresso e' sul gate, l'uscita e' sul source; il drain e' collegato direttamente all'alimentazione V_{DD}

Polarizzazione statica: sull'uscita si fissa di solito $V_S = V_{DS} = V_{DD}/2$, sulla porta d'ingresso si usano le stesse regole del CS.



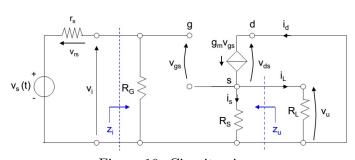


Figure 19: Circuito ai p.s

$$A_V = \frac{g_m(R_S /\!\!/ R_L)}{g_m(R_{ES} /\!\!/ R_L) + 1} < 1 \qquad z_i = R_G$$

$$z_u = \frac{1}{g_m} /\!\!/ R_S \cong \frac{1}{g_m} \text{ (solo se } \frac{1}{g_m} << R_S \text{)}$$

 $\underline{\mathbf{Nota}}\!:$ in centro banda il carico R_L e' in parallelo con R_S

7 Analisi in frequenza dei circuiti elettronici

E' possibile stimare in modo approssimato l'andamento in frequenza di un circuito, utilizzando il metodo delle costanti di tempo. Tale stima sara' tanto migliore quanto piu' ci si avvicina alle condizioni di polo dominante (poli distanti: >= 1 decade)

• <u>Cortocircuito</u> (alle basse frequenze): n capacita' di disaccopp. \Rightarrow n circuiti con una sola C_k e le altre n-1 cortocircuitate. Per ciascun circuito si calcola la $R_{(C_k)}$ "vista" ai capi di C_k

$$f_i \cong \frac{1}{2\pi} \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k R_{(Ck)}}$$

• <u>Circuito Aperto</u> (alle alte frequenze): p capacita' di comp.attivi \Rightarrow n circuiti con una sola C_k e le altre p-1 sono circuiti aperti. Per ciascun circuito si calcola la $R_{(Ck)}$ "vista" ai capi di C_k

$$f_s \cong \frac{1}{2\pi \sum_{k=1}^{p} C_k R_{(Ck)}}$$